

半 导 体 学 报

第 13 卷 第 12 期 1992 年 12 月

目 录

- 几种适用于 VLSI 离子注入新工艺的模型研究 牛国富 阮 刚 (721)
含Co 半磁半导体中铁杂质的红外吸收光谱
..... 朱景兵 陆 卫 刘普霖 史国良 刘卫军 沈学础 W. Giriat (729)
用数值法分析 TF-SOI-MOS 管沟道区的电势分布
..... 汤庭鳌 郑大卫 黄宜平 C. A. Paz de Araujo (736)
BiCMOS 比较器宏单元 杨肇敏 乌力吉 徐葭生 (742)
H 在 Pt/Si 上的化学吸附对 Pt/Si 界面特性的影响 徐国定 张 涛 (750)
快速热退火多晶硅薄膜压阻特性研究 曹子祥 黄永宏 王思杰 陈怀溥 (756)
- 研究简报**
- 显示 GaAs/AlGaAs 缺陷的新方法——超声 AB 腐蚀 陈诺夫 (763)
- 研究快报**
- Pb/Si (001)系统界面反应的 ELS 研究 赵汝光 贾金峰 杨威生 (767)
多孔硅量子约束效应导致的红外多光子激发荧光
王 健 蒋红兵 王文澄 郑家骥 张甫龙 郝平海 侯晓远 王 迅 (773)